

深圳市丽晶微电子科技有限公司

SHEN ZHEN ELITE CHIP MICROCIRCUIT CO.,LTD

一、概述

EC8002S

EC8002S 是一颗带关断模式的音频功放 IC。在 5V 输入电压下工作时，负载（4Ω）的最大输出功率为 2W。对于手提设备而言，当 VDD 作用于关断端时，EC8002S 将会进入关断模式，此时的功耗极低，IQ 仅为 0.6uA。

EC8002S 是专为中低档的应用场合所设计的音频功放 IC。所需外围元件少且在 2.5V~5.0V 的输入电压下即可工作。

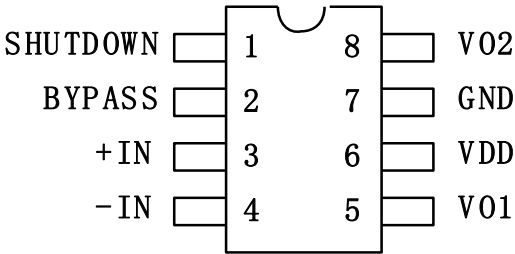
二、特点

- 1、无需输出耦合电容或外部缓冲电路。
- 2、稳定的增益输出。
- 3、外部增益设置。
- 4、封装形式：SOP-8。

三、产品应用

可应用于手提设备，台式电脑及低电压工作的音频设备。

四、管脚排列及说明：

管脚排列图	序号	名称	类型	说明
	1	SHUTDOWN	I	关断端口
	2	BYPASS	I	电压基准端
	3	+IN	I	正向输入端
	4	-IN	I	反向输入端
	5	VO1	O	音量输出端 1
	6	VDD	POWER	电源端
	7	GND	POWER	接地端
	8	VO2	O	音量输出端 2

注：I：输入；O：输出；POWER：电源。

五、功能说明

四、桥路设置

EC8002S 内部共有 2 个运放工作，但 2 个运放的设置却有所不同。

第一个运放增益可在外部用 RF 和 RJ 两个电阻进行设置（+IN 和 -IN 端口），而第二个运放的增益则固定不变。第一个运放的输出信号实际上是第二个运放的输入信号，而且两个运放产生的信号数量相同，相位相反。因此 EC8002S 增益如下： $A_{VD} = 2 \times (R_f/R_i)$

为驱动负载，运放设置成桥接方式。桥接方式不同于一些常见的运放电路把负载的一边接到地，在同等条件下能使负载产生 4 倍的输出功率。

深圳市丽晶微电子科技有限公司

SHEN ZHEN ELITE CHIP MICROCIRCUIT CO.,LTD

五、功耗

使用桥接的运放电路，负载上产生的功耗也比较大，因此在规定电压的条件下，负载功耗如下：

$$P_{D\text{MAX}} = 4 \times (V_{DD})^2 / (2\pi^2) R_L$$

因此在 5V 输入，8Ω 负载情况下，输出最大功耗为 625mW。但是此算法得出的结果如下：

$$P_{D\text{MAX}} = (T_{J\text{MAX}} - T_A) / \theta_{JA}$$

注：SOP 封装 $\theta_{JA}=140^\circ\text{C/W}$ ，DIP 封装 $\theta_{JA}=107^\circ\text{C/W}$ ，MSOP 封装 $\theta_{JA}=210^\circ\text{C/W}$

六、基准电压

电压基准端的外接电容应尽可能的靠近 EC8002S，0.1μF 的电容提高了内部偏置电压的稳定性并且减少了 PSRR 的影响。可以通过加大 BYPASS 端的对地电容值来改善 PSRR。CB 值的大小取决于对 PSRR 的要求。

七、关断功能

为了减少功耗，EC8002S 的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为高电平时，运放关闭，EC8002S 不工作，这时 EC8002S 的工作电流降低到 0.6uA。当关断端电压略低于 VDD 时，EC8002S 工作状态不稳定。所以，关断端应置于一个稳定的电压值，以免 IC 进入错误的工作状态。

在很多应用场合，关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时，可以在关断端加上拉电阻，这样当开关关断时，因上拉电阻的作用，使得 EC8002S 关断端的电平处于一个正确的状态，以保证 EC8002S 不会进入错误的工作状态。

六、极限参数(Ta=25℃)

特性	符号	范围	单位
工作电压	V_{DD}	5.5	V
输入电压	V_{IN}	-0.3~ $V_{DD}+0.3$	V
工作温度	T_{OPR}	-65~+150	℃
环境温度	T_A	-40~+85	℃
节点温度	T_J	150	℃

七、电气参数(VDD=5V, RL=8Ω, Ta=25℃)

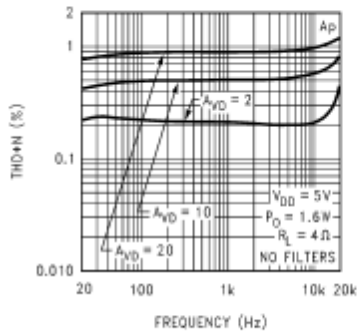
名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
工作电压	V_{DD}	2.5	--	5.0	V	
静态电流	I_{DD}	--	2	--	mA	$V_{IN}=0V$, $I_O=0mA$
关断电流	I_{SD}	--	0.6	2	uA	$V_{PIN1}=V_{DD}$
输出偏压	V_{OS}	--	5.0	50	mV	$V_{IN}=0V$
输出功率	P_O	--	1.28	--	W	THD=10%, f=1KHz, $R_L=8\Omega$
总谐波失真+噪音	THD+N	--	1.6	--	%	20Hz≤f≤20KHz, $A_{VD}=2$, $R_L=8\Omega$, $P_O=1W$
电源抑制比		--	60	--	dB	$V_{DD}=4.9V\sim 5.1V$

八、特性参数

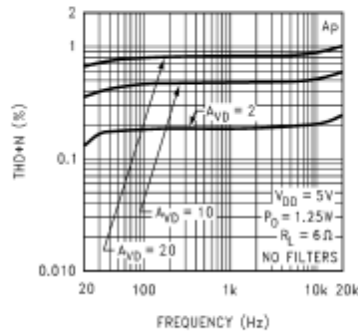
深圳市丽晶微电子科技有限公司

SHEN ZHEN ELITE CHIP MICROCIRCUIT CO.,LTD

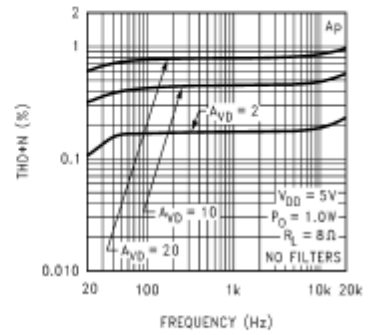
THD+N vs Frequency



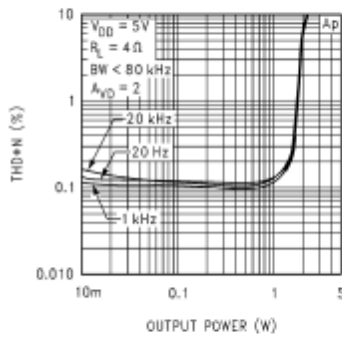
THD+N vs Frequency



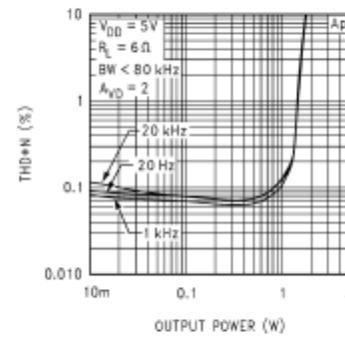
THD+N vs Frequency



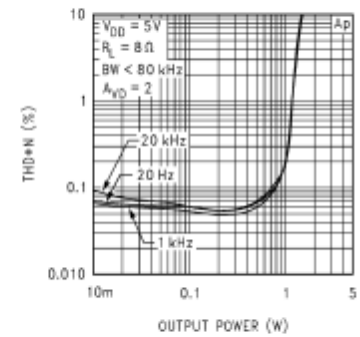
THD+N vs Output Power



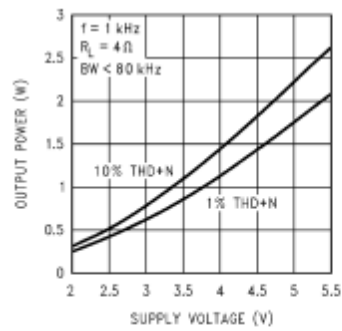
THD+N vs Output Power



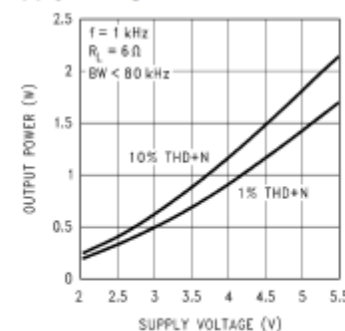
THD+N vs Output Power



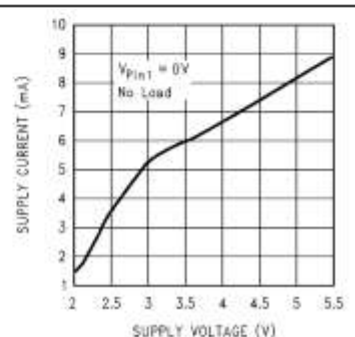
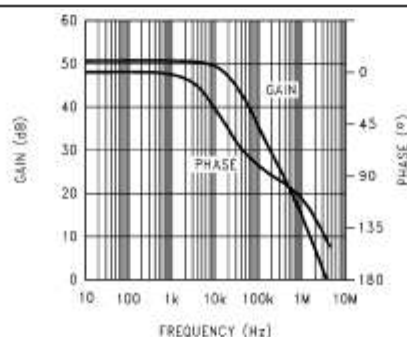
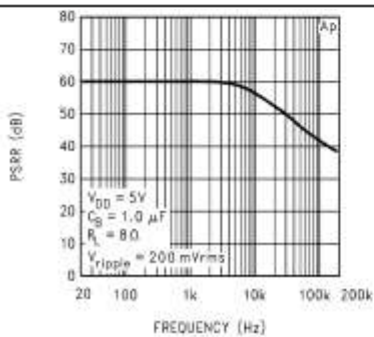
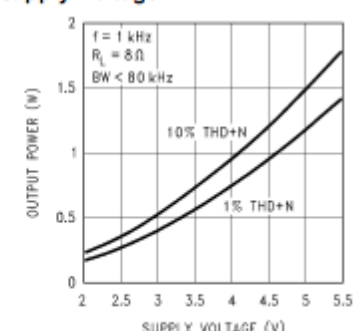
Output Power vs Supply Voltage



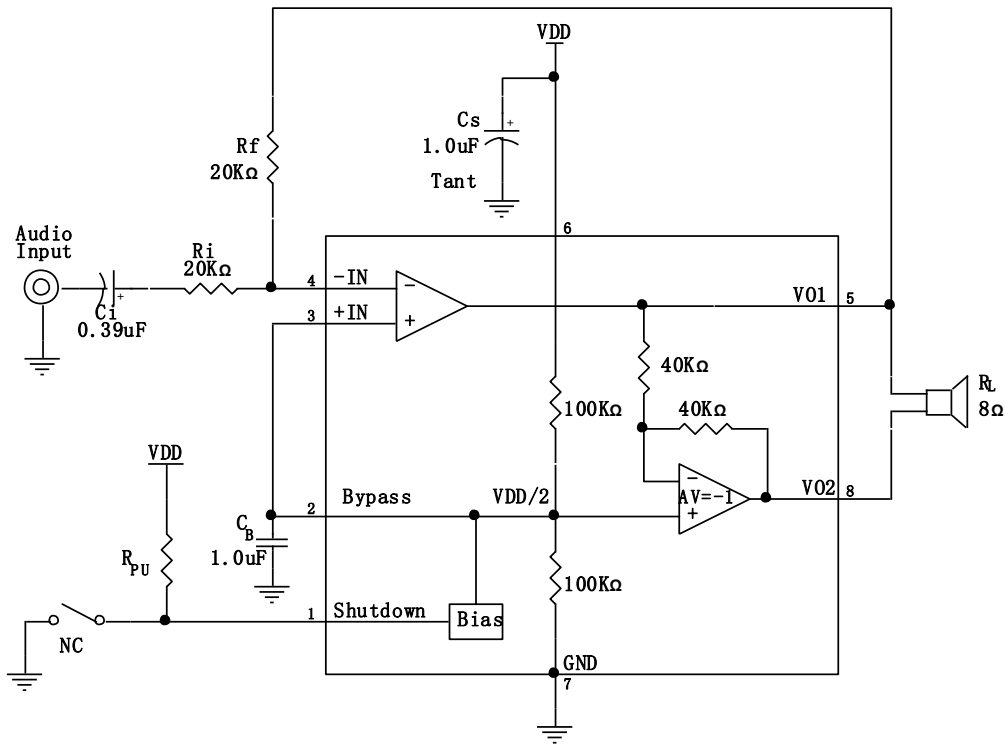
Output Power vs Supply Voltage



Output Power vs Supply Voltage



九、电路原理图



十、封装尺寸图

SOP-8

